








	<h2>SIHP18N50C-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP18N50C-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIHP18N50C-E3.pdf</a> <a href="#">2.SIHP18N50C-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1518 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP18N50C-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1518 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 18A (Tc) 223W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	223W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2942pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP18N50CE3

SIHP18N50C-E3 ist neu im Original, Suche SIHP18N50C-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP18N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP18N50C-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHP17N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 15A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP18N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 18A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP17N60D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP17N60D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>
 <p><b>SIHP20N50E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 19A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP17N60D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP20N50E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 19A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP21N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SIHFSL11N50A	↔ SIHG16N50C-E3	⇒ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	↔ SIHG20N50C
⊖ SIHG22N60S-E3	⊕ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	⇒ SIHG47N60E-E3	↔ SIHG47N60E-E3
⊕ SIHG47N60E-GE3	⊖ SIHG47N60E-GE3	⊕ SIHG47N60S-E3	↔ SIHG70N60EFEF-GE3	↔ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⊕ SIHP10N40D	⊖ SIHP12N50C-E3	⊕ SIHP12N50C-E3	↔ SIHP12N60E-E3
⇒ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-GE3	⊕ SIHP12N60E-GE3	⊖ SIHP12N65E	↔ SIHP14N50D
↔ SIHP15N60E-E3	⇒ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	⊕ SIHP16N50C-E3	⊖ SIHP16N50C-E3
⊕ SIHP17N60D-E3	D SIHP17N60D-E3	⇒ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP22N60S-E3	↔ SIHP30N60E-E3
⊖ SIHP30N60E-E3	⊕ SIHP30N60E-GE3	↔ SIHP30N60E-GE3	⇒ SIHP30N60E-GE3	↔ SIHP33N60E-GE3
⊕ SIHP33N60E-GE3	⊖ SIHP5N50D-E3	⊕ SIHP5N50D-E3	D SIHP6N40D	↔ SIHP8N50D-E3
↔ SIHP8N50D-E3	⊕ SIHU3N50D-E3	⊖ SIHU3N50D-E3	⊕ SIHW30N60E-GE3	↔ SIHW30N60E-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

